

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Косенок Сергей Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 11.06.2026 08:50:28
Уникальный программный ключ:
e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

Бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
"Сургутский государственный университет"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УМР
_____ Е.В. Коновалова
11 июня 2026 г., протокол УМС №5

МОДУЛЬ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН Электроника

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Экспериментальной физики**
Учебный план б030302-ЦифрТех-26-2.plx
03.03.02 Физика
Направленность (профиль): Цифровые технологии в геофизике

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 108

в том числе:

аудиторные занятия 64

самостоятельная работа 44

Виды контроля в семестрах:
контрольная работа 4 зачет 4

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	4 (2.2)		Итого	
	Неделя 17 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	32	32	32	32
Практические	32	32	32	32
Итого ауд.	64	64	64	64
Контактная работа	64	64	64	64
Сам. работа	44	44	44	44
Итого	108	108	108	108

УП: б030302-ЦифрТех-26-2.plx

Программу составил(и):

д.ф.-м.н., профессор, Ельников А.В.

Рабочая программа дисциплины

Электроника

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 03.03.02 Физика (приказ Минобрнауки России от 07.08.2020 г. № 891)

составлена на основании учебного плана:

03.03.02 Физика

Направленность (профиль): Цифровые технологии в геофизике

утвержденного учебно-методическим советом вуза от 11.06.2026 протокол № 5.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Экспериментальной физики

Зав. кафедрой д.ф.-м.н., профессор Ельников А.В.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | изучение принципов работы полупроводниковых элементов и устройств, достаточное для понимания и анализа работы функциональных узлов радиоэлектронной аппаратуры, в том числе генераторов и усилителей; формирование способности использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.О.07
--------------------	---------

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

- | | |
|-------|------------------------------------------------------|
| 2.1.1 | Оптика и квантовая физика |
| 2.1.2 | Основы проектной деятельности |
| 2.1.3 | Проект по дисциплине "Основы проектной деятельности" |
| 2.1.4 | Теория функций комплексного переменного |
| 2.1.5 | Учебная практика, ознакомительная практика |

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

- | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.1 | Квантовая теория |
| 2.2.2 | Механика жидкости и газа |
| 2.2.3 | Атомная и ядерная физика |
| 2.2.4 | Производственная практика |
| 2.2.5 | Производственная практика, научно-исследовательская работа |
| 2.2.6 | Тепломассоперенос |
| 2.2.7 | Государственная итоговая аттестация |
| 2.2.8 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы |
| 2.2.9 | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена |
| 2.2.10 | Производственная практика, преддипломная практика |

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**ОПК-2.1: Знает и понимает основные методы исследования физических объектов****ОПК-1.1: Знает и понимает теоретические основы основных разделов физики и математики****ОПК-1.2: Применяет полученные фундаментальные знания в области физики в профессиональной деятельности****В результате освоения дисциплины обучающийся должен****3.1 Знать:**

- | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.1 | Историю развития электроники в целом и полупроводниковой электроники в частности, физические основы процессов происходящих в полупроводниках элементах и устройствах; |
| 3.1.2 | элементную базу электроники; |

3.2 Уметь:

- | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.1 | Выполнять измерения и визуализировать параметры эксперимента; |
| 3.2.2 | представлять результаты измерений и их интерпретацию; выполнять информационный и эвристический поиск; |
| 3.2.3 | вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий; |
| 3.2.4 | обосновывать полученные научные знания; |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Примечание
	Раздел 1. 1. Структура и типы полупроводниковых диодов					
1.1	Вольт – амперная характеристика (ВАХ) полупроводникового диода. Инжекция носителей. Прямая и обратная ветви ВАХ. Тепловой и электрический пробой p-n перехода. Выпрямительные диоды. Стабилитроны. Переходные процессы при переключении реальных диодов. Физические причины инерционности процессов в реальных диодах. Частотные свойства диодов. Импульсные диоды. /Лек/	4	8	ОПК-1.1 ОПК-1.2	Л1.2Л2.2 Л2.1 Э1	
1.2	Вольт – амперная характеристика (ВАХ) полупроводникового диода. Инжекция носителей. Прямая и обратная ветви ВАХ. Тепловой и электрический пробой p-n перехода. /Пр/	4	4	ОПК-1.1 ОПК-1.2	Л1.2	
1.3	Контактные явления на границе раздела металл – полупроводник. Барьер Шоттки. Диоды Шоттки. Контактные явления на границе полупроводник – полупроводник. Электронно – дырочный (p-n) переход. Зона обеднения и емкость p-n перехода. Варикап. /Ср/	4	13	ОПК-1.2 ОПК-2.1	Л1.2Л3.2 Э1	
1.4	Применение полупроводниковых диодов /Пр/	4	4	ОПК-1.2 ОПК-2.1	Л2.2Л3.1 Э1	
1.5	Стабилитроны. Переходные процессы при переключении реальных диодов. Физические причины инерционности процессов в реальных диодах. /Пр/	4	4	ОПК-1.1 ОПК-1.2	Л3.1	
	Раздел 2. 2. Биполярные тран-зисторы					
2.1	Структура и принцип действия биполярных транзисторов. Их назначение и использование в электронных схемах. Режимы работы транзисторов: активный, насыщения, отсечки. Схемы включения транзисторов. Входные и выходные характеристики. Система h – параметров биполярного транзистора. Параметры транзисторов при различных схемах включения. Схемы замещения. Динамические характеристики. /Лек/	4	8	ОПК-1.1 ОПК-1.2	Л1.2Л2.2 Л2.1	
2.2	Динамическая модель транзистора Эберса – Молла. Составной транзистор (схема Дарлингтона). /Ср/	4	3	ОПК-1.1 ОПК-1.2	Л1.2Л3.2 Э1	
2.3	Структура и принцип действия биполярных транзисторов. Их назначение и использование в электронных схемах. Режимы работы транзисторов: активный, насыщения, отсечки. Схемы включения транзисторов. /Пр/	4	4	ОПК-1.1 ОПК-1.2		
2.4	Исследование биполярных транзисторов /Пр/	4	2	ОПК-1.1 ОПК-1.2	Л2.2Л3.1 Э1	
	Раздел 3. 3. Полевые транзисторы					

3.1	Принцип работы и классификация полевых транзисторов. Полевой транзистор с управляющим р-п переходом. Выходные и сток – затворные характеристики полевых транзисторов. МОП – транзисторы: транзисторы с встроенным и с индуцированным каналом. Преимущества и область применения полевых транзисторов. /Лек/	4	8	ОПК-1.1 ОПК-1.2	Л1.2Л2.2 Л2.1	
3.2	Полевой транзистор с управляющим р-п переходом. Выходные и сток – затворные характеристики полевых транзисторов. МОП – транзисторы: транзисторы с встроенным и с индуцированным каналом. /Пр/	4	4	ОПК-1.1 ОПК-1.2		
3.3	Оптические свойства полупроводников. Поглощение света. Люминесценция. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. Фоторезистивный эффект. Когерентная и некогерентная оптоэлектроника. /Ср/	4	24	ОПК-1.1 ОПК-1.2	Л1.2Л3.2 Э1	
3.4	Исследование характеристик полевых транзисторов /Пр/	4	8	ОПК-1.1 ОПК-1.2	Л2.2Л3.1	
Раздел 4. 4. Тиристоры						
4.1	Классификация тиристоров по структуре, числу выводов и способу управления. Условные обозначения. Принцип работы и ВАХ динистора. Тиристоры с управлением по катоду и по аноду. Двухтранзисторная модель тиристора . Анализ процессов в тиристоре в зависимости от тока управления. Переходные процессы при включении и выключении тиристора. Симисторы. Фототиристоры. Область применения. /Лек/	4	8	ОПК-1.1 ОПК-1.2	Л1.2Л2.2 Л2.1	
4.2	Светодиоды: принцип действия, параметры и основные характеристики. Фотоприемники: внутренний фотоэффект, фотоЭДС. Параметры и характеристики фотодиодов. Оптроны: характеристики, параметры, применение. Полупроводниковые лазеры /Ср/	4	4	ОПК-1.1 ОПК-1.2	Л1.1 Л1.2Л3.2 Э1	
4.3	Исследование тиристора /Пр/	4	2	ОПК-2.1	Л2.2Л3.1	
4.4	Исследование биполярных транзисторов /Контр.раб./	4	0	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-2.1		
4.5	/Зачёт/	4	36	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-2.1	Э1	

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации

Представлены отдельным документом

5.2. Оценочные материалы для диагностического тестирования

Представлены отдельным документом

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
6.1. Рекомендуемая литература				
6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Опадчий Ю. Ф., Гуров А. И., Глудкин О. П.	Аналоговая и цифровая электроника: полный курс	М.: Горячая линия-Телеком, 2017	29
Л1.2	Максина Е. Л.	Электроника: Учебное пособие	Саратов: Научная книга, 2012, электронный ресурс	1
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Водовозов А. М.	Основы электроники: Учебное пособие	Вологда: Инфра-Инженерия , 2016, электронный ресурс	1
Л2.2	Водовозов А.М.	Основы электроники: учебное пособие	Москва: Инфра-Инженерия , 2016, электронный ресурс	1
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л3.1	Табарин В. А., Иконников В. П.	Физические основы электроники: (Лабораторный практикум)	Сургут: Издательство СурГУ, 2004	179
Л3.2	Марченко А. Л., Опадчий Ю. Ф.	Электротехника и электроника: курсовые работы с методическими указаниями и примерами	Москва: ООО "Научно-издатель ский центр ИНФРА-М", 2015, электронный ресурс	1
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России) https://www.gpntb.ru/			
6.3.1 Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	Операционные системы Microsoft, пакет прикладных программ Microsoft Office.			
6.3.2 Перечень информационных справочных систем				
6.3.2.1	http://www.garant.ru Информационно-правовой портал Гарант.ру			
6.3.2.2	http://www.consultant.ru/ Справочно-правовая система Консультант Плюс			
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
7.1	учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена: комплект специализированной учебной мебели, маркерная (меловая) доска, комплект переносного мультимедийного оборудования - компьютер, проектор, проекционный экран, компьютеры с возможностью выхода в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную среду организации.			